

SBDブリッジダイオード
SBD Bridge Diode

シングルインライン型
Single In-line Package

D4SBN20

200V 4A

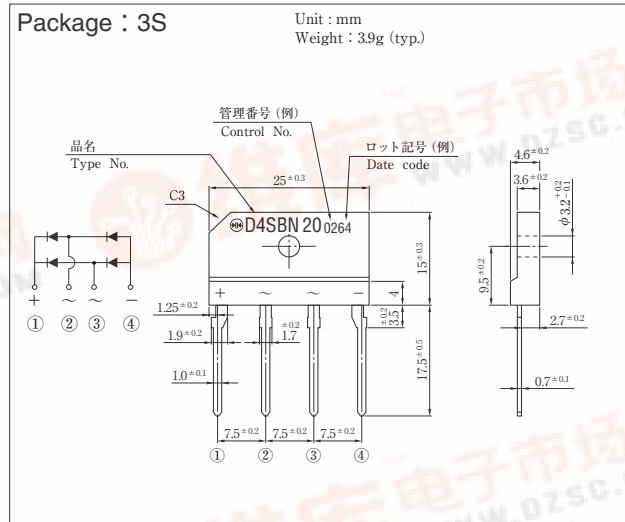
特長

- 薄型SIPパッケージ
- SBDブリッジ
- 低VF・低IR

Feature

- Thin-SIP
- SBD Bridge
- Low VF・Low IR

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は Tc=25℃ / unless otherwise specified)

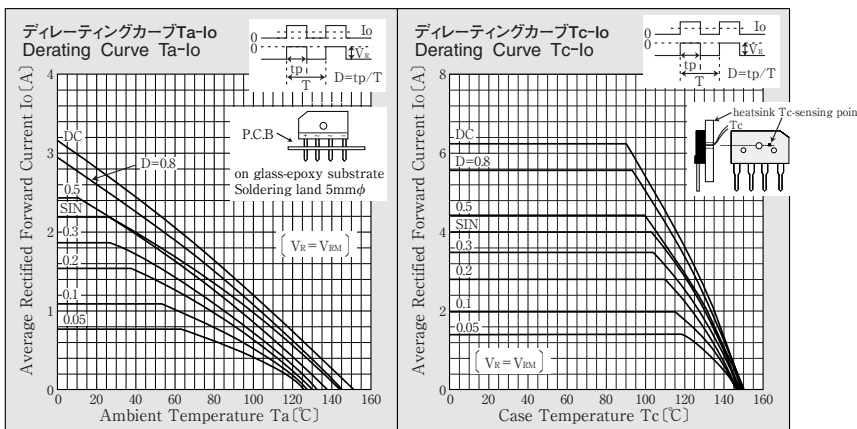
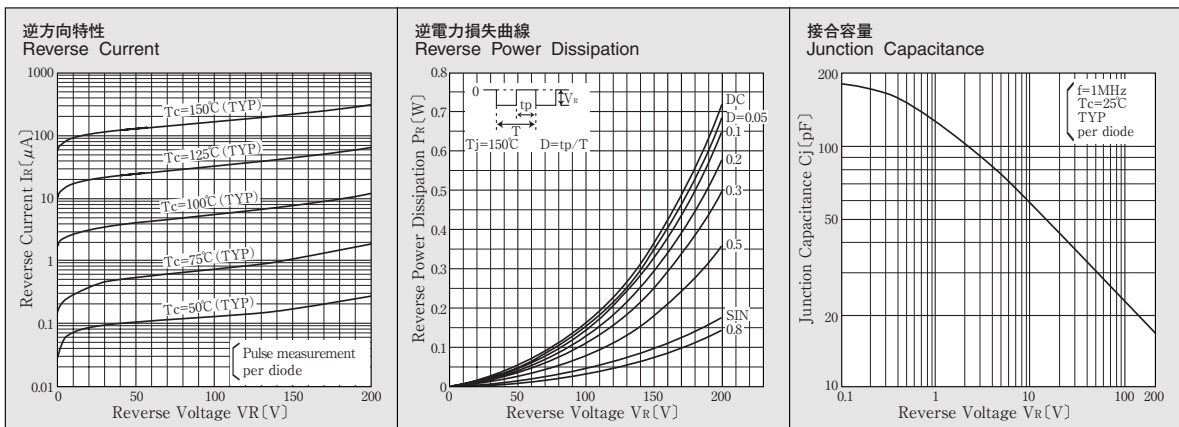
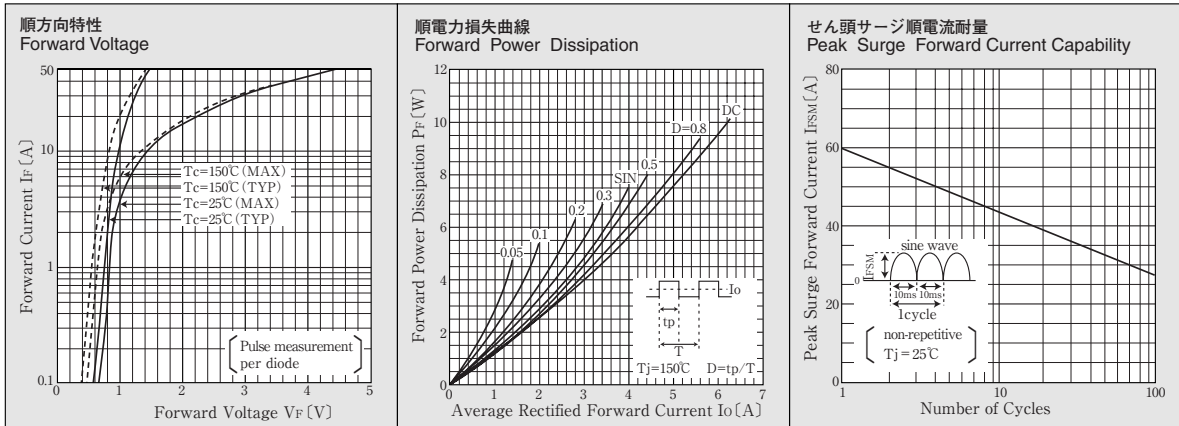
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D4SBN20	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}			-55~150	℃	
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	℃	
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			200	V	
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	T _c =103℃	4.0	A
			フィンなし Without heatsink	T _a =25℃	2.2	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j =25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25℃		60	A	
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.0	kV	
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque : 0.5 N·m)		0.8	N·m	

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は Tc=25℃ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Specification	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =2A, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.90	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =200V, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.5	μA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f=1MHz, V _R =10V, 一素子当たりの規格値 per diode	TYP 60	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間, フィン付き junction to case, With heatsink	MAX 6.0	℃/W
	θ _{jl}	接合部・リード間 junction to lead	MAX 8.0	
	θ _{ja}	接合部・周囲間 junction to ambient	MAX 35	



■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.